熱電硫化銅鉱物におけるラットリングと熱電物性

末國, 晃一郎 九州大学大学院総合理工学研究院

https://doi.org/10.15017/1932036

出版情報:九州大学低温センターだより. 12, pp.2-6, 2018-03. Kyushu University Low Temperature Center バージョン: 権利関係:

熱電硫化銅鉱物におけるラットリングと熱電物性

末國晃一郎 九州大学 大学院総合理工学研究院

1. はじめに

固体素子を用いて熱エネルギーと電気エネルギーを相互に直接変換する方法を熱電変換と呼ぶ。 この技術を用いれば、未利用の自然熱や廃熱からの電力回収(熱電発電/温度差発電)および冷媒を 必要としない冷却・温調(電子冷却/ペルチェ冷却)が可能になる。前者は、素子の両端に温度差を 与えるとその間に起電力が生じるというゼーベック効果に基づき、後者は、電流を印加するとその両 端で吸熱または放熱が起きるというペルチェ効果に基づく^{1,2}。実用的に意味がある熱電発電素子の発 電効率およびペルチェ冷却素子の成績係数は、素子物質の無次元性能指数 ZT が高いほど増大する。 この ZT はゼーベック係数 S,電気抵抗率 ρ ,熱伝導率 $\kappa = \kappa_{\rm C} + \kappa_{\rm L}$ ($\kappa_{\rm C}$:電荷キャリアの寄与、 $\kappa_{\rm L}$:格 子の寄与)を用いて ZT = $S^2 T \rho^{-1} \kappa^{-1}$ と表される。したがって、Sが大きく、 $\rho \ge \kappa$ が低い物質が高性能 な熱電物質である。これらのパラメーターの中で S $\ge \rho$ および $\kappa_{\rm C}$ は電荷キャリア密度 n に依存する。 具体的には、n を増やす $\ge S \ge \rho$ が減少する一方で $\kappa_{\rm C}$ は増加する。したがって、ZT を最大にするには n を最適化する必要がある。その最適値はほとんどの物質において 10¹⁹–10²¹ cm⁻³ であるため、熱電物 質は縮退半導体や半金属である。もう一つのパラメーターである $\kappa_{\rm L}$ は n にはほとんど依存しない。熱 電物質では電荷キャリアが少なく $\kappa_{\rm el}$ よりも $\kappa_{\rm L}$ の方が支配的であるため、 $\kappa_{\rm L}$ を独立して低減させれば ZT は飛躍的に増大すると期待される。

格子振動(フォノン)に由来する κ_L は、フォノンの比熱 C_L 、群速度 v、および平均自由行程 $l \in I$ いて $\kappa_L = (1/3)C_L v l \geq \pm$ される。この関係によれば、物質の $\kappa_L \in K_L$ 減させるには、 $v \in K_L < \pm 1/2$ 短くすればよい。実際に、従来の熱電物質には重元素からなるために v が低いものが多い。また、元素置換、第二相の導入、粒子のナノサイズ化により $l \in \Xi$ くして $\kappa_L \in F$ げることでバルク試料の ZT が高められている³。他方、本質的に低い $\kappa_L \ge K_L$ の を併せ持つ物質の設計指針として、Slack は「Phonon-Glass Electron-Crystal」を提案した⁴。これは、フォノンにとってはガラスのように乱れており、電荷キャリアにとっては(半導体)結晶のように高移動度である物質の探索を促すものであった。



図1 充填スクッテルダイト,I型クラスレートおよびテトラヘドライトの結晶構造

この指針はその後,カゴ状構造を有する充填スクッテルダイトと I 型クラスレートの開発に繋がった (図 1)^{5,0}。これらの物質では,熱を伝える音響フォノンはカゴに内包されたゲスト原子の大振幅非 調和振動(ラットリング)に起因して強く散乱される一方,電荷キャリアはカゴ上を高移動度で流れ ることができる。

我々は最近,カゴ状構造を持たないテトラヘドライト Cu₁₂Sb₄S₁₃ という硫化銅鉱物において Cu 原 子がラットリングしており(図 1),極端に低い κ_Lのために高い ZT が発現することを報告した^{7,8}。 その後,ラットリングと音響フォノンとの相互作用に関する知見を得るために,低温での比熱と熱伝 導率を調べた⁹。さらに,X線回折実験(結晶構造解析)と中性子非弾性散乱実験(フォノン構造解 析)により,ラットリングの原因を調べるとともに,Cu₁₂Sb₄S₁₃が 85 K で示す相転移とラットリング の関係を調べた^{10,11)}。以下では,テトラヘドライトに関するこれら4つの研究^{7,11)}について紹介する。

2. 熱電物性

標題の鉱物は地球上に広く分布しており、その組成は(Cu,Fe,Zn)₁₂(Sb,As)₄S₁₃のように表される。他 方、人工物の組成はCu_{12×}Tr_xSb₄S₁₃(Tr: 3d 遷移金属元素)などと書かれる。その立方晶(I-43m)構造は、 (Cu/Tr)S₄ と CuS₃ および SbS₃の 3 つのユニットから成り、単位胞に 58 個もの原子を含むため複雑であ る (図 1)。我々は、原料単体の直接反応により試料を合成し、その焼結体を物性測定に用いた。

まず、テトラヘドライトの母物質 Cu₁₂Sb₄S₁₃ は正の高い S (~100 μ V K⁻¹) と比較的低い ρ (~10⁵ Ω m) を併せ持ち、さらに、極めて低い κ_L (≤ 0.5 W/Km) を示すことを報告した ^{7,8}。この電気的特性は、 第一原理計算から得られた電子構造が p 型の縮退半導体的であることと符合する ¹²。ここで、フェル ミ準位近傍に分散が弱い複数のバンドが存在することが高い S の原因であろう。次に、S4 四面体中

(図 1)の Cu(1)の一部を Ni で置換してホールキャリア密度を減少させた。その結果,出力因子 S^2/ρ は減少したものの, κ_c が大幅に抑制されたために ZT

は増大した(図 2)⁸。具体的には,母物質の*ZT*は 665 K において 0.5 であるが, Cu_{10.5}Ni_{1.5}Sb₄S₁₃ では 0.7 と 40%向上した。この温度域で高い*ZT*を示すテ トラヘドライトは,車載用発電素子としての応用が 期待される。また,人体に安全で資源が豊富な Cu と S を主成分とするため,従来の高性能物質である PbTe や PbSe¹³⁾の代替物質として有望である。

我々の報告とほぼ同時期に米国のグループによ り報告された Zn と Fe 置換系も同等の高い ZT を示 した¹⁴⁾。その後, Ni と Zn を共置換した Cu_{10.5}Ni_{1.0}Zn_{0.5}Sb₄S₁₃が700 K において ZT = 1 を示す ことが報告された¹⁵⁾。また最近では, Cu の Mn, Fe, Co, Ni, Zn 置換系⁷⁾にとどまらず, Cu の Ge, Sn 置換系, Sb の Te 置換系, S の Se 置換系の熱電物性も調べら れている^{16,17)}。これらの置換元素をうまく組み合わ せれば, ZT はさらに高まると期待される。



図2 テトラヘドライト^{8,14,15)}および PbTeとPbSe¹³⁾の無次元性能指数 ZT

3. ガラス的な熱伝導率

我々は、放射光 X 線構造解析により、S₃三角形中の Cu(2)が面直方向にラットリングすることを明 らかにした(図1)⁸⁾。カゴ状物質からの類推で、テトラヘドライトにおいてもラットリングに起因し て κ_L が抑制されていると予想した。そこで、ラットリングと音響フォノンの相互作用に関する知見を 得るために低温における比熱と熱伝導率の測定を行った⁹⁾。この測定には、非磁性の半導体であり、 後述の相転移を示さない Cu₁₀Zn₂Sb₄S₁₃ を用いた。比熱の解析からラットリングの特性エネルギーは

1.7 meV と低いことが判った。また, $\kappa(T) \approx \kappa_L(T)$ は非 晶質固体的なプラトーを示し、1 K 以下で温度の 1.6 乗に従った(図 3)。この冪は、結晶性固体に特有の 3 乗というよりはむしろ、非晶質固体の 2- δ 乗に近い。 このようなテトラヘドライトの低温物性は、ラットリ ング原子をもたないコルーサイト Cu₂₃Zn₃V₂Sn₆S₃₂ に おいて、局在的振動モードの特性エネルギーが 7.8 meV と高く、 $\kappa(T)$ が結晶的なピークをとった後に温度 の 2.5 乗で減少することと対照的である。これらの比 較から、Cu₁₀Zn₂Sb₄S₁₃では、Cu(2)のラットリングモー ドにより音響フォノンが共鳴的に散乱されており、そ の結果ガラス的なプラトーが生じたと結論した。また、 そのような低エネルギーモードが存在することにより ウムクラップ散乱の頻度が高められ¹⁸、高温における κ が抑制されていると予想した。

余談ではあるが,カゴ状 I 型クラスレート Ba₈Ga₁₆Sn₃₀においても Ba ゲストの振動特性エネルギ ーは2 meV と低く, κ_L(*T*)はプラトーを示し,低温で温 度の 1.9 乗に従う^の。結晶構造が全く異なるクラスレ ートとテトラヘドライトにおけるよく似た振る舞いの 原因を今後統一的に理解する必要がある。

4. ラットリングの起源

この研究では、4 種類のテトラヘドライト Cu₁₂Sb₄S₁₃ (Sb), Cu₁₀Zn₂Sb₄S₁₃ (ZnSb), Cu₁₂As₄S₁₃ (As), Cu₁₀Zn₂As₄S₁₃ (ZnAs) を合成し、結晶構造と格子振動



図3 テトラヘドライト Cu₁₀Zn₂Sb₄S₁₃と ラットリングのないコルーサイト Cu₂₃Zn₃V₂Sn₆S₃₂の熱伝導率κ



図4 S₃三角形の面積に依存する Cu の面 直方向の原子変位パラメーターU

を調べた¹⁰。その結果, すべての試料において Cu(2)は S₃ 三角形に垂直な方向にラットリングしてい るが, その振幅の2乗(原子変位パラメーター)が異なっていた。さまざまな結晶構造パラメーター の相関を調べた結果, S₃ 三角形の面積が小さくなるとともに, Cu(2)の原子変位パラメーターが増大す ることが明らかになった(図4)。この結果より, ラットリングは, S₃ 三角形内で化学的圧力を受けた Cu が面外に逃れることにより生じると予想した。実際に, S₃ 三角形の面積が縮小するのに伴いラット リングエネルギーは低下した, つまり, Cu 原子が振動し易くなることが示された。この結果は, 平面 配位ラットリングを有する新しい熱電物質の開発に繋がると期待される。

5. ラットリング誘起相転移

 $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ は 85 K で磁化率 χ の急減と比熱のピーク を伴う相転移を示す(図 5)。過去の研究では、この相 転移は Cu^{2+} の反強磁性秩序に因ると考えられていた。 しかし我々の試料では、Cu 2p X線光電子分光から Cuは 1 価であると判った¹¹⁾。また、この相転移で ρ が急 増したことから(図 5)、電子状態密度に比例するパウ リ常磁性成分が消失したために χ が減少したと結論し た¹¹⁾。さらに、X 線構造解析から、この相転移は構造 変態を伴うことを示した。具体的には、室温相で立方 晶 (*I*-43*m*: *a*×*a*×*a*)であった構造が低温相では正方晶 (*I* 格子: 2*a*×2*a*×2*c*) に変化する。また、関連物質であ る $Cu_{12}As_4S_{13}$ はより高い温度の 124 K で相転移するこ とも判った(図 5)。 $Cu_{12}Sb_4S_{13}$ と $Cu_{12}As_4S_{13}$ では相転 移の機構が異なる可能性があり、現在その詳細を調べ ている。

我々はさらに、Cu₁₂Sb₄S₁₃において相転移に伴うフ オノン構造の変化を観測した¹⁹⁾。図6に示す中性子非 弾性散乱スペクトルを見ると、Cu(2)のラットリングモ ードに由来する290 K で 3.2 meV のピークは、降温に 伴い幅が広がり、エネルギーが低下する。ピークのす そは100 K では1 meV 以下にまで伸びる。転移温度以 下では再び2 meV に明瞭なピークが出現し、降温と共 にソフト化する。これらの結果から、Cu のラットリン グの部分的な凍結に起因して相転移が起きたと考えら れる。

6. おわりに

本稿では、テトラヘドライトの熱電物性および低温 物性について紹介した。この物質では、Cu 原子のラッ トリングに起因して κ_L が低く抑えられ、熱電性能が高 められている。さらに、κ_L(*T*)のガラス的な挙動と構造 相転移という興味深い物性が発現する。このように、 テトラヘドライトは熱電応用と物性物理の観点から魅 力的な研究対象である。ラットリングを有する物質で は、他にも、重い電子状態の形成や超伝導の発現など



図 5 Cu₁₂Sb₄S₁₃ と Cu₁₂As₄S₁₃の 電気抵抗率 ρ,磁化率 χ,比熱 Cの 温度依存性



図 6 Cu₁₂Sb₄S₁₃のラットリングモードの 温度依存性

の多彩な現象が報告されている²⁰⁾。ほとんどの場合,研究の対象はカゴ状物質であったが,テトラヘドライトのような平面配位構造にも目を向けると,物質探索の範囲は飛躍的に拡がるだろう。実際に 最近,平面配位ラットリングを示す層状物質のLaOBiSSeが発見されている^{21,22)}。今後,ラットリン グ物質を対象とした物性研究の更なる進展に期待したい。

7. 謝辞

以上の研究成果は,北陸先端大 小矢野幹夫 教授,広島大 高畠敏郎 教授,筑波大 西掘英治 教授, 産総研 太田道広 主任研究員,李哲虎 主任研究員をはじめとする国内の研究者,そして多くの学生と の共同研究により得られたものである。本稿で紹介した研究成果の一部は,科研費若手 (B) (JSPS), 革新的エネルギー技術国際共同研究開発事業 (産総研,経済産業省), CREST (JST)の支援を受けて 行われた。紙面を借りて感謝申し上げる。

引用文献

- 1) 熱電変換 一基礎と応用一, 坂田 亮 編, (裳華房, 2005).
- 2) 熱電材料の物質科学, 寺崎一郎, (内田老鶴圃, 2017).
- 3) K. Biswas *et al.*, Nature **489**, 414 (2012).
- Slack, G.A., in CRC Handbook of Thermoelectrics, edited by D. M. Rowe (CRC Press, Boca Raton, FL, 1995), pp. 407–440.
- 5) G. S. Nolas, D. T. Morelli, T. M. Tritt, Annu. Rev. Mater. Sci. 29, 89 (1999).
- 6) T. Takabatake, K. Suekuni et al., Rev. Mod. Phys. 86, 669 (2014).
- 7) K. Suekuni et al., Appl. Phys. Express 5, 051201 (2012).
- 8) K. Suekuni et al., J. Appl. Phys. 113, 043712 (2013).
- 9) K. Suekuni et al., J. Phys. Soc. Jpn. 84, 103601 (2015).
- 10) K. Suekuni et al., Adv. Mater. (2017), in print.
- 11) H. I. Tanaka, K. Suekuni et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 014703 (2016).
- 12) K. Suekuni et al., J. Appl. Phys. 115, 143702 (2014).
- 13) A. D. LaLonde et al., Materials Today 14, 526 (2011).
- 14) X. Lu et al., Adv. Energy Mater. 3, 342 (2013).
- 15) X. Lu et al., Chem. Mater. 27, 408 (2015).
- 16) K. Suekuni and T. Takabatake, APL Mater. 4, 104503 (2016).
- 17) Y. Kosaka, K. Suekuni et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 8874 (2017).
- 18) C. H. Lee et al, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 123602 (2006).
- 19) 末國ら,日本物理学会,2015 年秋季大会,16pCD-12.
- 20) 高畠敏郎, 藤秀樹, 固体物理 47, No. 11, 547 (2012).
- 21) Y. Mizuguchi et al., J. Appl. Phys. 119, 155103 (2016).
- 22) C. H. Lee et al., Appl. Phys. Lett. 112, 023903 (2018).